

**Examen de Electrónica 2**  
**26/02/2014**

Resolver cada problema en hojas separadas.

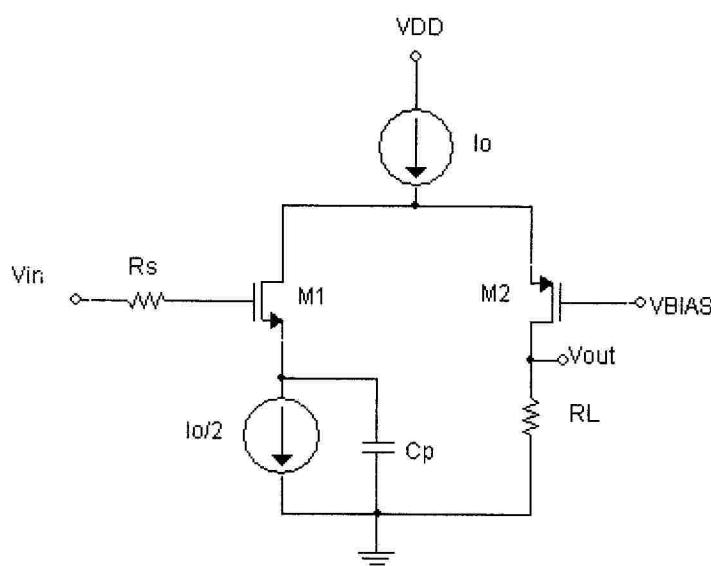
Duración de la prueba: 3 horas 30 minutos.

La prueba es sin material.

Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos.

**Problema 1: ( 34 puntos)**

- Para el amplificador de la Figura calcular la ganancia  $V_{out}/V_{in}$  a frecuencias medias.
- Calcular la frecuencia de corte superior.
- ¿Como se compara este resultado con el caso de un source común con la misma carga  $R_L$ ?



**Datos:**

$$R_s = R_L = 5\text{ k}\Omega, I_o = 4\text{ mA}.$$

Los transistores son idénticos con:  $\beta_N = \beta_P = 2 \text{ mA/V}^2$ ,  $C_{ox} = 1,9 \times 10^{-3} \text{ pF}/\mu\text{m}^2$ ,  $W = 1000 \mu\text{m}$ ,

$$L = 2 \mu\text{m}, C_{gso} = C_{gdo} = 0,5 \times 10^{-3} \text{ pF}/\mu\text{m}.$$

VDD, VBIAS y la tensión continua de Vin son tales que los transistores trabajan en saturación, el condensador de desacople  $C_p$  se considerará infinito.

**Problema 2: ( 38 puntos)**

- Para el oscilador de la Figura calcular frecuencia y condición de oscilación.
- Si la relación  $G_m/g_{mQ}$  en función de la relación  $V_p/(VGS-VT)$  es la dada en la Figura 2, ¿cuál es el valor de la amplitud de las oscilaciones ?  
 ( $V_p$  es la amplitud de la señal entre Gate y Source del transistor ,  $VGS$  es el valor de la tensión Gate-Source de polarización y  $VT$  la tensión umbral del transistor).

- c) ¿Cuál es la mínima corriente de polarización que garantiza el arranque del oscilador?

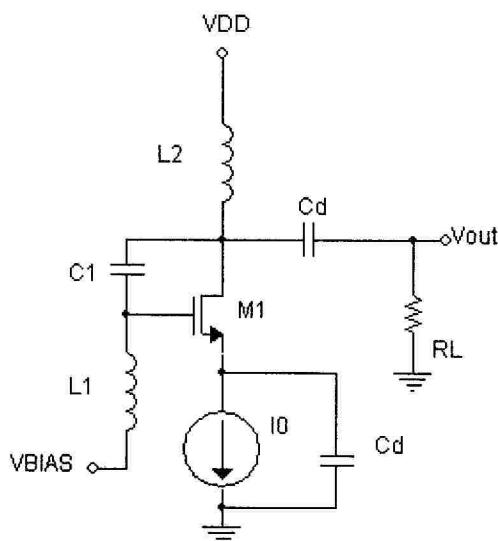


Figura 1

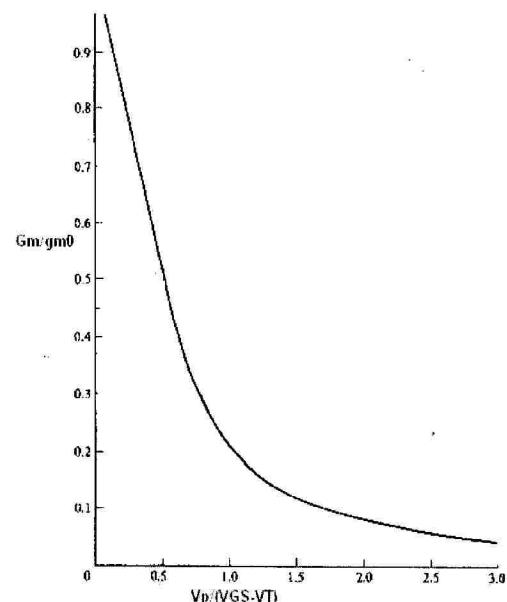


Figura 2

**Datos:**

$R_L = 400\Omega$ ,  $L_1 = L_2 = 1\mu H$ ,  $C_1 = 126,7 \text{ pF}$ , los condensadores  $C_d$  se podrán considerar infinitos.

$V_{DD} = 10V$

Para M1:  $\beta = 5\text{mA/V}^2$ ,  $I_0 = 15\text{mA}$ , la polarización es tal que el transistor trabaja en la zona de saturación.

**Pregunta : ( 28 puntos)**

Se tiene una etapa de salida clase B implementada con un par complementario TIP 41 / TIP 42, (cuyos datos se muestran en la hoja adjunta); alimentado con  $\pm 15V$  y cargado con una resistencia de  $4\Omega$  a tierra.

Calcular:

- La máxima potencia que se puede entregar a la carga.
- La máxima potencia que debe disipar cada transistor para todos los valores de amplitud de pico a la salida y la eficiencia del circuito cuando se está disipando esta potencia.
- Si los transistores están sin disipador y la máxima temperatura ambiente es de  $45^\circ C$ , cuál es la máxima potencia que el circuito puede entregar a la carga sin dañar los transistores y a qué temperatura de juntura corresponde esta potencia.
- Si los transistores tienen un disipador con una resistencia térmica de  $4^\circ C/W$ , en contacto con el encapsulado del transistor con una resistencia térmica de  $0.5^\circ C/W$ , cuál es la máxima potencia que el circuito puede entregar a la carga sin dañar los transistores.

Considerar en todo el problema despreciables las tensiones base-emisor y de saturación.

**MOTOROLA**  
 SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA

 Order this document  
 by TIP41A/D

**Complementary Silicon Plastic Power Transistors**

. . . designed for use in general purpose amplifier and switching applications.

- Collector-Emitter Saturation Voltage —  
 $V_{CE(sat)} = 1.5 \text{ Vdc (Max) } @ I_C = 6.0 \text{ Adc}$
- Collector-Emitter Sustaining Voltage —  
 $V_{CEO(sus)} = 60 \text{ Vdc (Min) } — \text{TIP41A, TIP42A}$   
 $= 80 \text{ Vdc (Min) } — \text{TIP41B, TIP42B}$   
 $= 100 \text{ Vdc (Min) } — \text{TIP41C, TIP42C}$
- High Current Gain — Bandwidth Product  
 $f_T = 3.0 \text{ MHz (Min) } @ I_C = 500 \text{ mAdc}$
- Compact TO-220 AB Package

**\*MAXIMUM RATINGS**

Rating	Symbol	TIP41A TIP42A	TIP41B TIP42B	TIP41C TIP42C	Unit
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	60	80	100	Vdc
Collector-Base Voltage	$V_{CB}$	60	80	100	Vdc
Emitter-Base Voltage	$V_{EB}$		5.0		Vdc
Collector Current — Continuous Peak	$I_C$		6	10	Adc
Base Current	$I_B$		2.0		Adc
Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$ Derate above $25^\circ\text{C}$	$P_D$		65	0.52	Watts W/ $^\circ\text{C}$
Total Power Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ Derate above $25^\circ\text{C}$	$P_D$		2.0	0.016	Watts W/ $^\circ\text{C}$
Unclamped Inductive Load Energy (1)	$E$		62.5		mJ
Operating and Storage Junction Temperature Range	$T_J, T_{stg}$		-65 to +150		$^\circ\text{C}$

 **THERMAL CHARACTERISTICS**

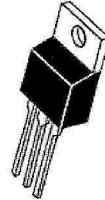
Characteristic	Symbol	Max	Unit
Thermal Resistance, Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	62.5	$^\circ\text{C/W}$
Thermal Resistance, Junction to Case	$R_{\theta JC}$	1.92	$^\circ\text{C/W}$

(1)  $I_C = 2.5 \text{ A}$ ,  $L = 20 \text{ mH}$ , P.R.F. = 10 Hz,  $V_{CC} = 10 \text{ V}$ ,  $R_{BE} = 100 \Omega$ .

NPN  
**TIP41A**  
**TIP41B\***  
**TIP41C\***  
 PNP  
**TIP42A**  
**TIP42B\***  
**TIP42C\***

\*Motorola Preferred Device

6 AMPERE  
 POWER TRANSISTORS  
 COMPLEMENTARY  
 SILICON  
 60-80-100 VOLTS  
 65 WATTS



CASE 221A-06  
 TO-220AB

Preferred devices are Motorola recommended choices for future use and best overall value.

REV 1

© Motorola, Inc. 1995



Ref: Pagina 1 de la hoja de datos del fabricante Motorola

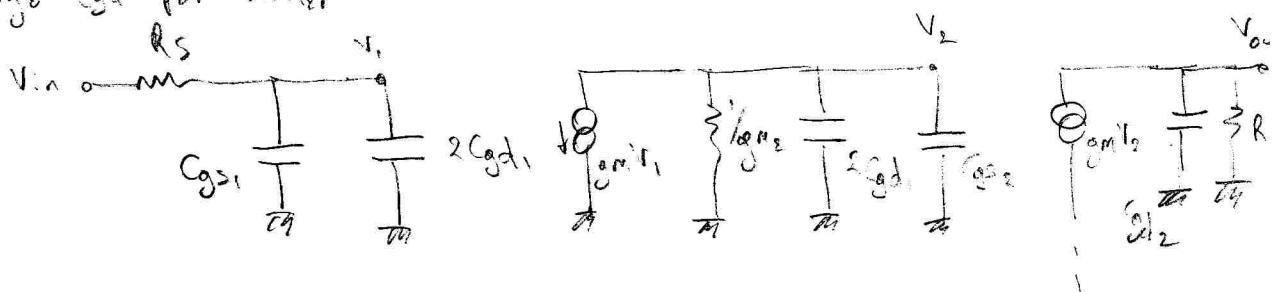
## Problem 2)

$$2) \quad I_{D1} = I_{D2} = I_0/2 \quad | \quad \Rightarrow g_{m1} = g_{m2} = \sqrt{2\beta I_0/2} = 2.8 \text{ nA/V}$$

transistors identicos

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\tan \phi_1 = -2.8 \times 10^{-3} \cdot 5 \times 10^3 = -14 \text{ V/V}$$

b) Bigo Cgd for Miller



$$C_{gd1,2} = w \cdot C_{gd05} = 0,5 \mu F$$

$$C_{GS,1,2} = \frac{2}{3} W \cdot L \cdot C_{ox} + W \cdot C_{GS,0,1} = 3 \cdot F$$

$$f_{p1} = \frac{1}{2\pi R_S (2C_{gd1} + C_{gs1})} = 7.8 \text{ Hz}$$

$$f_{pe} = \frac{1}{2\pi \cdot 1/g_m (2(g_{d1} + g_{s2})} = 112 \text{ MHz}$$

$$f_{p3} = \frac{1}{2\pi \cdot R_L \cdot g_{dr}} = 64 \text{ MHz}$$

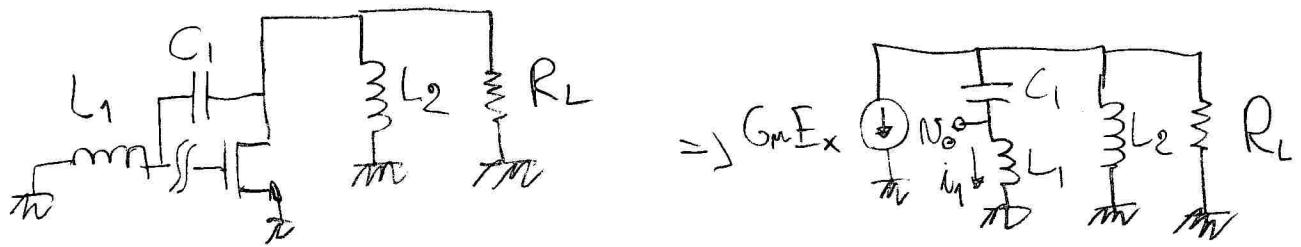
c) En el caso del sonido común el polo

de la solid se mzn fine ( $f_{\beta}$ ) y el

*Arribó el 21 de enero de 1952 a 286° 30' S.*

$$f_{\text{p}^*} = \frac{1}{2\pi\cdot h_5 (g_{\text{S}^*} + g_{\text{S}^*})} = 3,2 \text{ MHz}$$

2)



$$N_o = L_1 \Delta i_1$$

$$i_1 = \frac{-(L_2 \Delta || R_L) G_m E_x}{(L_2 \Delta || R_L) + L_1 \Delta + \frac{1}{C_1 \Delta}}$$

$$(L_2 \Delta || R_L) = \frac{L_2 R_L \Delta}{L_2 \Delta + R_L}$$

$$\Rightarrow i_1 = \frac{-G_m E_x}{1 + \left[ \frac{C_1 L_1 \Delta^2 + 1}{C_1 \Delta} \right] \left[ \frac{L_2 \Delta + R_L}{L_2 R_L \Delta} \right]}$$

$$\frac{N_o}{E_x} = \frac{-C_1 L_1 L_2 G_m R_L \Delta^3}{C_1 L_1 L_2 \Delta^3 + (L_1 + L_2) C_1 R_L \Delta^2 + L_2 \Delta + R_L} = A\beta(\Delta)$$

$$\Rightarrow A\beta(j\omega_0) = \frac{C_1 L_1 L_2 G_m R_L j\omega^3}{-C_1 L_1 L_2 j\omega_0^3 - (L_1 + L_2) C_1 R_L \omega_0^2 + L_2 j\omega_0 + R_L}$$

$$\Rightarrow R_L - (L_1 + L_2) C_1 R_L \omega_0^2 = 0 \Rightarrow \boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{(L_1 + L_2) C_1}}}$$

$$\Rightarrow A\beta(j\omega_0) = \frac{C_1 L_1 L_2 G_m R_L \omega_0^3}{K_2 \omega_0 - C_1 L_1 L_2 \omega_0^3}$$

$$\Rightarrow A\beta(j\omega_0) = \frac{C_1 L_1 G_m R_L \omega_0^3}{1 - C_1 L_1 \omega_0^2} = \frac{C_1 L_1 G_m R_L \omega_0^2}{1 - \frac{L_1}{L_1 + L_2}}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{G_m R_L L_1}{L_2} = 1}$$

b) De la condición de saturación espejo  $G_m$

$$\Rightarrow G_m = \frac{L_2}{R_L L_1} = 2,5 \text{ mA/V}$$

$$g_{m2} = \sqrt{2\beta I_o} = 12,2 \text{ mA/V} \quad \Rightarrow \quad \underline{G_m = 0,2} \\ g_{m2}$$

$$\Rightarrow \text{De la tabla } \frac{V_p}{V_{GS}-V_A} = 1$$

$$\frac{\beta(V_{GS}-V_A)^2}{2} = I_o \Rightarrow (V_{GS}-V_A) = \sqrt{\frac{2I_o}{\beta}} = 2,45 \text{ V}$$

$$\Rightarrow V_p = 2,45 \text{ V}$$

$$\Rightarrow V_o = G_m V_p R_L$$

$$\boxed{V_o = 2,45 \text{ V}}$$

c) La condición de arranque es  $\underline{g_{m2} R_{LL} > 1}$

$$L_1 = L_2$$

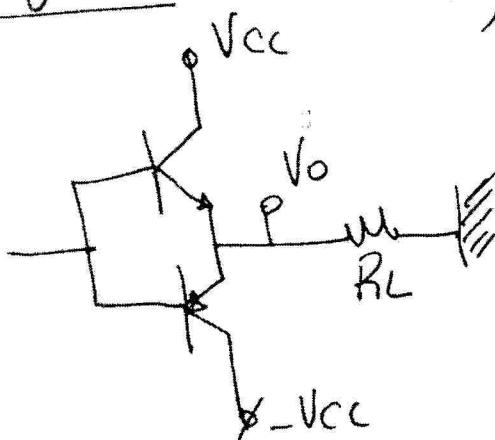
$$\nexists \Rightarrow g_{m2} R_L > 1 \Rightarrow \sqrt{2\beta I_o} > \frac{1}{R_L} \Rightarrow 2\beta I_o > \frac{1}{R_L^2}$$

$$\Rightarrow I_o > \frac{1}{2\beta R_L^2} \Rightarrow$$

$$\boxed{I_{o_{\min}} = 625 \text{ mA}}$$

# Electrónica 2

Tarea 2:



$$2) \text{ Pmáx corfa} = \frac{V_{cc}^2}{2R_L} = 28W$$

$\uparrow V_o = V_{cc}$

$$2) \text{ Pmáx disipado por cada transistor} = \frac{\frac{1}{2}V_{cc}^2}{\pi^2 R_L} = 5.7W$$

que ocurre cuando  $V_o = \frac{2V_{cc}}{\pi}$

El rendimiento es 50%.

$$3) \theta_{jA} = 62.5^\circ C/W$$

150°C	45°C
" " "	" "

$$\text{Pmáx disipable en disipador} = \frac{T_{j\max} - T_A}{\theta_{jA}} =$$

$$= 1.68W$$

$$P_{disipado} = \frac{V_o}{\pi R_L} V_{cc} - \frac{1}{4} \frac{V_o^2}{R_L} = 1.68W$$

$$\Rightarrow V_o = 2.53V \rightarrow P_L = 0.3W$$

$$T_j = 150^\circ C$$

$$4) \theta_{jA} = \theta_{jc} + \theta_{cs} + \theta_{sa} = 6.42^\circ C/W$$

1.82	0.5	4

$$\Rightarrow \text{Pmáx disponible} = \frac{150 - 45}{6.42} = 16.35W$$

que es menor que lo calculado en 2)  $\Rightarrow P_{máx} = 28W$   
 como en 2)